

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第3676379号
(P3676379)

(45) 発行日 平成17年7月27日(2005.7.27)

(24) 登録日 平成17年5月13日(2005.5.13)

(51) Int.Cl.⁷

H05K 3/46

F I

H05K 3/46

S

請求項の数 13 (全 16 頁)

(21) 出願番号	特願平10-500397	(73) 特許権者	旭化成エレクトロニクス株式会社
(86) (22) 出願日	平成8年12月19日(1996.12.19)		東京都新宿区西新宿1丁目23番7号
(86) 国際出願番号	PCT/JP1996/003712	(74) 代理人	弁理士 加々美 紀雄
(87) 国際公開番号	W01997/047165	(74) 代理人	弁理士 酒井 正己
(87) 国際公開日	平成9年12月11日(1997.12.11)	(74) 代理人	弁理士 小松 純
審査請求日	平成14年7月1日(2002.7.1)	(72) 発明者	片寄 照雄
(31) 優先権主張番号	特願平8-145348	(72) 発明者	木下 昌三
(32) 優先日	平成8年6月7日(1996.6.7)		神奈川県川崎市中原区上小田中1丁目37-3-101
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		
(31) 優先権主張番号	特願平8-179579		
(32) 優先日	平成8年7月9日(1996.7.9)		
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 多層配線板用樹脂付金属箔、その製造方法、多層配線板、および電子装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

金属箔の片面に比誘電率が1メガヘルツ以上の周波数領域で3.3以下の熱硬化性樹脂の膜を有し、樹脂フロー量が1%以上50%以下であることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

【請求項2】

金属箔の片面に比誘電率が1メガヘルツ以上の周波数領域で3.3以下の熱硬化性樹脂の膜を有し、樹脂フロー量が5%以上50%以下であることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

【請求項3】

請求の範囲第1項または請求の範囲第2項の逐次多層配線板用樹脂付金属箔のうち、熱硬化性樹脂が無機充填材を含んでなることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

【請求項4】

請求の範囲第1項、請求の範囲第2項または請求の範囲第3項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔のうち、熱硬化性樹脂が硬化されたときガラス転移温度が180℃以上であることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

【請求項5】

請求の範囲第1項、請求の範囲第2項、請求の範囲第3項または請求の範囲第4項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔のうち、熱硬化性樹脂が熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂であることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

【請求項 6】

請求の範囲第 5 項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔において、熱硬化性樹脂がポリスチレン系重合体を含む熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂であることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

【請求項 7】

熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂と溶剤からなる樹脂ワニスを金属箔に塗布し、得られた塗布膜を乾燥するにあたって、溶剤の蒸発速度が $0.10 \text{ g} / (\text{cm}^2 \cdot \text{分})$ 以下となる条件下で乾燥することを特徴とする請求の範囲第 5 項または請求の範囲第 6 項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔の製造方法。

【請求項 8】

熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂と溶剤からなる樹脂ワニスを金属箔に塗布し、得られた塗布膜を乾燥するにあたって、熱硬化性樹脂の塗布膜の残存溶媒濃度が 200000 ppm に達するまでの溶剤の蒸発速度が $0.10 \text{ g} / (\text{cm}^2 \cdot \text{分})$ 以下となる条件下で乾燥することを特徴とする請求の範囲第 5 項または請求の範囲第 6 項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔の製造方法。

【請求項 9】

請求の範囲第 5 項または請求の範囲第 6 項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔の製造方法において、熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂を実質的に分解させない条件下で溶解、押し出しすることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔の製造方法。

【請求項 10】

容易に剥離可能な樹脂面保護シートを有することを特徴とする請求の範囲第 1 項～第 6 項の何れか一項に記載の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

【請求項 12】

請求の範囲第 1 項、請求の範囲第 2 項、請求の範囲第 3 項、請求の範囲第 4 項または請求の範囲第 5 項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔を逐次に積層することにより配線層を形成したことを特徴とする逐次多層配線板。

【請求項 13】

請求の範囲第 1 2 項の逐次多層配線板に配線手段を用いて電子素子を接続したことを特徴とする電子装置。

【請求項 14】

電気信号の伝搬速度が $1 \text{ ナノ秒あたり } 16.5 \text{ cm}$ 以上であり、かつ耐熱温度が 180 以上である請求の範囲第 1 2 項の逐次多層配線板と電子素子からなる請求の範囲第 1 3 項の電子装置。

【発明の詳細な説明】

技術分野

本発明は熱硬化性樹脂の膜を片面に有する多層配線板用樹脂付金属箔、その製造方法、該多層配線板用樹脂付金属箔を用いた多層配線板、および該多層配線板と電子素子が配線手段を用いて接続された電子装置に関する。本発明の多層配線板は配線層間の距離が多層配線板の面内の位置にかかわらず実用上一定と見なせ、特性インピーダンスのばらつきが小さい。そのため、超高速デジタル回路用の配線板として非常に優れた特性を有する。本発明の電子装置は特性インピーダンスの安定性が優れており、電子素子としてデジタル半導体が搭載されていれば、デジタル半導体により高速に動作することができる。電子素子としてアナログ部分を有する半導体は、信号のクロストークが減少するためより高周波の信号を扱うことができる。また、熱硬化した樹脂のガラス転移温度が 180 以上であることにより本発明の多層配線板および電子装置は非常に高い信頼性を有する。熱硬化前の熱硬化性樹脂の比誘電率が 1 メガヘルツ 以上の周波数で 3.3 以下と低いことにより、その熱硬化性樹脂が硬化されて用いられた本発明の多層配線板は特性インピーダンスの安定性、信号の高速伝送性、低クロストーク性に優れる。この多層配線板を用いた電子装置においては、デジタル半導体は最も高速に、アナログ信号を扱う半導体は最も高い周波数で動作することができる。

10

20

30

40

50

背景技術

熱硬化性の樹脂膜を有する金属箔としては従来エポキシ樹脂付銅箔が知られている。しかしながら、樹脂付金属箔を繰り返し積層することを特徴とする多層配線板（逐次多層配線板）の製造方法、いわゆる積層ビルドアップ工法においてこのような従来の樹脂付金属箔を用いた場合には、電気絶縁体として機能する該熱硬化性樹脂の膜厚を配線板内のいたるところ一定として配線の特性インピーダンスを一定範囲内に収めることが困難であった。また、該熱硬化性樹脂の誘電特性や耐熱性は、該熱硬化性樹脂が高速回路および高周波アナログ回路を考慮したものではないためそれらの用途に用いるには不十分であった。従来の銅張積層板製造用エポキシ樹脂を用いた樹脂付金属箔においては、樹脂の誘電率は3.6～3.9、硬化した樹脂のガラス転移温度は120～150に過ぎなかった。

10

電気用配線板産業の分野では、めっきスルーホール工法よりも高密度な配線を形成しうる積層ビルドアップ工法の確立が急務とされているが、高速デジタル回路および高周波アナログ回路に用いることができる適切な多層配線板用樹脂付金属箔がなかった。本発明は特定範囲の樹脂フロー、比誘電率、硬化後のガラス転移温度の熱硬化性樹脂の膜を片面に有する金属箔を用い、高速デジタル回路および高周波アナログ回路に用い得る多層配線板およびそれを用いた電子装置を提供しようとするものである。

発明の開示

本発明者らは鋭意検討の結果、樹脂付金属箔の発明に到った。本発明は次に述べる13の発明より構成される。

本願の第1発明は、金属箔の片面に比誘電率が1メガヘルツ以上の周波数領域で3.3以下の熱硬化性樹脂の膜を有し、樹脂フロー量が1%以上50%以下であることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

20

本願の第2発明は、金属箔の片面に比誘電率が1メガヘルツ以上の周波数領域で3.3以下の熱硬化性樹脂の膜を有し、樹脂フロー量が5%以上50%以下であることを特徴とする逐次多層配線板の樹脂付金属箔。

本願の第3発明は、請求の範囲第1項または請求の範囲第2項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔のうち、熱硬化性樹脂が無機充填材を含んでなることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

本願の第4発明は、請求の範囲第1項、請求の範囲第2項または請求の範囲第3項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔のうち、熱硬化性樹脂が硬化されたときガラス転移温度が180以上であることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

30

本願の第5発明は、請求の範囲第1項、請求の範囲第2項、請求の範囲第3項または請求の範囲第4項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔のうち、熱硬化性樹脂が熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂であることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

本願の第6発明は、請求の範囲第5項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔において、熱硬化性樹脂がポリスチレン系重合体を含む熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂であることを特徴とする逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

本願の第7発明は、熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂と溶剤からなる樹脂ワニスを金属箔に塗布し、得られた塗布膜を乾燥するにあたって、溶剤の蒸発速度が $0.10\text{ g / (cm}^2 \cdot \text{分)}$ 以下となる条件下で乾燥することを特徴とする請求の範囲第5項または請求の範囲第6項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔の製造方法。

40

本願の第8発明は、熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂と溶剤からなる樹脂ワニスを金属箔に塗布し、得られた塗布膜を乾燥するにあたって、熱硬化性樹脂の塗布膜の残存溶媒濃度が20000ppmに達するまでの溶剤の蒸発速度が $0.10\text{ g / (cm}^2 \cdot \text{分)}$ 以下となる条件下で乾燥することを特徴とする請求の範囲第5項または請求の範囲第6項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔の製造方法。

本願の第9発明は、請求の範囲第5項または請求の範囲第6項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔の製造方法において、熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂を実質的に分解させない条件下で溶融、押し出しすることを特徴とする逐次多層配線板用樹脂付金属箔の製造方法。

50

本願の第10発明は、容易に剥離可能な樹脂面保護シートを有することを特徴とする請求の範囲第1項～第6項の何れか一項に記載の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔。

本願の第11発明は、請求の範囲第1項、請求の範囲第2項、請求の範囲第3項、請求の範囲第4項または請求の範囲第5項の逐次多層配線板用の樹脂付金属箔を逐次に積層することにより配線層を形成したことを特徴とする逐次多層配線板。

本願の第12発明は、上記第11発明の逐次多層配線板に配線手段を用いて電子素子を接続したことを特徴とする電子装置。

本願の第13発明は、電気信号の伝搬速度が1ナノ秒当たり16.5cm以上であり、かつ耐熱温度が180℃以上である上記第11発明の逐次多層配線板と電子素子からなる上記第12発明の電子装置。

10

【図面の簡単な説明】

第1図は、本発明の熱硬化性樹脂付着金属箔の構造を示す断面図である。第2図は、第11発明の逐次多層配線板の構造の一例を示す断面図である。第3図は、第11発明の逐次多層配線板の製造工程の一例を示す断面図である。第4図乃至第6図は、第12発明の電子装置の構造の例を示す断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下にこの発明を詳しく説明する。

本発明中の金属箔としてはどのようなものも用いることができるが、例えば銅箔、アルミ箔、錫箔、金箔などが挙げられる。容易に入手できかつ容易にエッチングできることから銅箔、アルミ箔が好ましく、銅箔は最も好ましい。金属箔の厚みは特に限定されないが、扱い易さの点から500μm以下が好ましく、200μm以下がより好ましく、105μm以下が最も好ましい。金属箔の熱硬化性樹脂の膜が形成される側の面は該樹脂との密着性を強めるため、粗面化および/またはカップリング処理されていてもよい。配線板製造用として製造販売されている粗化处理電解銅箔は、本発明の多層配線板用樹脂付銅箔の製造にそのまま用いることができる。金属箔は本発明の多層配線板の導体として主に使用されるが、放熱を目的として使用されることもある。金属箔はそれらの目的に応じて選ばれる。

20

第1図に、本発明の熱硬化性樹脂付金属箔の構造を断面図として示す。同図において、1は金属箔、2は熱硬化性樹脂の膜である。

本発明中の熱硬化性樹脂については、樹脂フロー量が1%以上50%以下の熱硬化性樹脂であれば所望の著しい効果を得ることができる。樹脂フロー量は5%以上50%以下がより好ましく、7%以上45%以下が最も好ましい。1%未満の樹脂フロー量では内層回路の埋め込み不良を発生し、多層配線板の形成が困難である。樹脂フロー量は大きい方が内層回路の埋め込みが容易であるが、50%を越える樹脂フロー量では絶縁層の厚みを配線板内で一定に保つことができず、配線の特性インピーダンスを一定に保つことができない。

30

樹脂フロー量は、以下の方法で測定される。

(1) 10cm×10cmの金属箔の重量を測定し、この重量をaとする。

(2) 10cm×10cmの樹脂付金属箔の重量を測定し、この重量をbとする。

(3) 上記の樹脂付金属箔を温度170℃において圧力22kg/cm²で10分間加圧した後、金属箔からはみ出した樹脂分を取り除き、残った樹脂付金属箔の重量を測定し、この重量をb'とする。

40

(4) 下記に示す式により、樹脂フロー量を求める。

$$\text{樹脂フロー量 (\%)} = \left[1 - \frac{b' - a}{b - a} \right] \times 100$$

本発明に用いられる熱硬化性樹脂としては例えば、熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂、フェノール樹脂、低誘電率化エポキシ樹脂、ジアリルフタレート樹脂、ジビニルベンゼン樹脂、多官能性アクリロイル樹脂、多官能性メタクリロイル樹脂、多官能性マレイミド樹脂、多官能性シアン酸エステル樹脂、多官能性イソシアネート樹脂、不飽和ポリエステル

50

ル樹脂、ポリブタジエン樹脂、スチレン・ブタジエン・スチレン・ブタジエン・スチレン等の架橋性ポリマーなどが挙げられる。これらの樹脂は、工業技術上当然のことであるが、単一の化合物とは限らず、所望の性質を得るために様々な他の物質が添加され、あるいは変性が施されて用いられる。熱硬化性樹脂に熱可塑性樹脂がブレンドされてもよい。本発明においては熱硬化性樹脂の比誘電率が3.3以下であって、かつ多層配線板用樹脂付金属箔となされたときに樹脂フロー量が請求の範囲に規定の範囲であることが必須である。

上記の熱硬化性樹脂の例のうち、本発明の樹脂付金属箔に用いられる熱硬化性樹脂として好ましいものは、熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリスチレン系重合体を含む熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリジビニルベンゼンを含む樹脂組成物、ポリブタジエンを含む樹脂組成物、トリアリルシアヌレートおよび/またはトリアリルイソシアヌレートの重合体および/または共重合体を含む樹脂組成物である。

以下、これらの熱硬化性樹脂について説明する。

一般に硬化物のガラス転移温度が高く、しかも比誘電率が硬化前後とも3.0以下であり、かつフロー特性の調節が可能な熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂は特に好ましい樹脂である。熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂としては、例えば特許公開平7-165846に記載の組成物、特許公開平7-166049に記載の組成物、特許公告平7-37567に記載の組成物、特許公告平7-26013に記載の組成物等が挙げられる。ポリスチレン系重合体を樹脂組成物全体を100重量部としてそのうち1~20重量部となるように添加したものは、樹脂膜の平滑性および強靱性に優れるというより好ましい特徴を有する。

ここに言うポリスチレン系重合体とは、スチレンのホモポリマーもしくはスチレンの構造単位数が全繰返し単位数の80%以上であるような任意の熱可塑性コポリマーを指す。重量平均分子量は、1万以上であることが好ましい。

本発明におけるポリジビニルベンゼンとは、ジビニルベンゼンおよび/またはその水素原子が任意の原子団で置換されたジビニルベンゼン誘導体を重合あるいは共重合して得られる重合体のうち、ジビニルベンゼンおよび/またはジビニルベンゼン誘導体の2個の不飽和2重結合の片方だけが重合され片方が残った物を指す。このような重合体としては、例えば特許公告平4-1902に記載の重合体が挙げられる。全繰返し単位数のうちジビニルベンゼンまたはジビニルベンゼン誘導体由来の繰返し単位が占める割合は5%以上が好ましく、10%以上がより好ましい。重量平均分子量は、1万以上が好ましい。

本発明における多官能性シアン酸エステル樹脂について説明する。多官能シアン酸エステルは、炭素-窒素三重結合の熱3量化反応でトリアジン環を形成して架橋し、硬化する。多官能性シアン酸エステルは、単量体のまま、あるいは部分的に3量化を施したプレポリマーの形で、多官能性シアン酸エステル樹脂として用いられる。本発明においては、膜状の形態をなして用いる都合上、室温で半固体状のプレポリマーが好ましい。

本発明におけるポリブタジエンとは、公知のポリ(1,3-ブタジエン)を指す。数平均分子量は500以上5万以下が好ましい。500以上1万以下がより好ましく、500以上5000以下が最も好ましい。数平均分子量が500未満では粘度が低すぎるし、5万を越えると粘度が高くなりすぎる。

トリアリルシアヌレートおよび/またはトリアリルイソシアヌレートの重合体および/または共重合体も本発明の樹脂付金属箔の熱硬化性樹脂として好適に用いることができる。この重合体または共重合体は、トリアリルシアヌレートおよび/またはトリアリルイソシアヌレートを、例えばトルエンのような溶媒中で、例えば有機過酸化物のような重合開始剤の存在下に加熱し、アリル基の一部を重合することによって得られる。分子構造は直線状であっても分岐を有していても、どちらでもよい。重量平均分子量は、1000以上10万以下が好ましく、2000以上10万以下がより好ましい。

本発明では、熱硬化性樹脂に、その用途に応じて所望の性能を付与させる目的で本来の性質を損なわない範囲の量の充填剤や添加剤を配合して用いることができる。充填剤は繊維状であっても粉末状であってもよく、シリカ、アルミナ、酸化チタン、チタン酸バリウム

10

20

30

40

50

、タルク、雲母、ガラスビーズ、ガラス中空球、アラミド繊維等を挙げることができる。充填材は熱膨張率の低減、誘電率の調節などの目的で本発明において有効に利用される。添加剤としては、難燃剤、酸化防止剤、熱安定剤、帯電防止剤、可塑剤、顔料、染料、着色剤等が挙げられる。

無機充填材の添加は、樹脂層の耐熱性および電気特性において著しい効果を有するので好ましい。シリカおよびガラス中空球は最も好ましい無機充填剤の例である。

熱硬化性樹脂膜の厚さは特に限定されないが、 $10\text{ }\mu\text{m}$ 以上が好ましく、 $20\text{ }\mu\text{m}$ 以上がより好ましく、 $30\text{ }\mu\text{m}$ 以上が最も好ましい。極端に膜厚が小さいと積層ビルドアップ工法を行うことが困難になる。

熱硬化性樹脂膜を形成する方法としては、どのような手段によってもよいが、好ましい方法としては例えば、該樹脂を溶剤に溶解もしくは分散させたワニス塗布、乾燥させる方法が挙げられる。溶剤は樹脂の選択に応じて適した物が選ばれる。また、別の好ましい方法として、無溶剤で溶解製膜する方法も挙げられる。

金属箔と熱硬化性樹脂膜を密着した形態になす方法は、一切限定されない。樹脂膜は直接に金属箔上に形成してもよいし、あらかじめ別にフィルム状に形成したものを金属箔に加熱加圧等の手段によって密着させてもよい。膜状になされた樹脂の上に蒸着、スパッタリングあるいは化学めっきなどの公知の手段によって金属皮膜を形成するという手順を取ることでもできる。

熱硬化性樹脂が熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂もしくはポリスチレン系重合体を含む熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂であって、熱硬化性樹脂の樹脂ワニスからの製膜による製造方法を採用する場合は、本件第7発明および第8発明の特別な製造方法を用いることにより、樹脂膜から粉落ちすることがなく、かつ樹脂膜表面に乾燥割れのない良好な品質の樹脂付金属箔を、高い生産性で製造することができる。

ポリフェニレンエーテル樹脂のワニスの調製に用いる溶剤としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族系炭化水素、ジクロロメタン、クロロホルム、トリクロロエチレンなどのハロゲン系溶剤、さらにはTHF等があげられるが、これらは単体もしくは混合して使用できる。熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂と溶剤とからなるワニスを塗布する方法としては、エアードコータ、ブレードコータ、ロッドコータ、ナイフコータ、グラビアコータ、リバースコータ、キャストコータなどの装置を用いる方法が挙げられる。塗布膜を乾燥する方法としては、熱風乾燥、ロール加熱乾燥、赤外線乾燥、遠赤外線乾燥等の装置を用いる方法が挙げられ、実施にあたってはこれらの装置が単独で、あるいは2種以上を組み合わせ用いられてもよい。

次に、熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂と溶剤からなる樹脂ワニスを塗布し、塗布膜を乾燥するにあたっての蒸発速度について説明する。本発明における塗布膜を乾燥するにあたっての蒸発速度の具体的コントロール方法としては、例えば、乾燥するための熱風の温度、風量を調節することが挙げられる。また、蒸発温度をコントロールするため、高沸点溶剤をワニスに添加しても良い。このような高沸点溶剤としては、クロルベンゼン、テトラリン、アニソール等が挙げられる。

本発明において、溶剤の蒸発速度は、 $0.10\text{ g}/(\text{cm}^2 \cdot \text{分})$ 以下であることが必要であるが、好ましくは、蒸発速度が $0.001\text{ g}/(\text{cm}^2 \cdot \text{分})$ 以上、 $0.10\text{ g}/(\text{cm}^2 \cdot \text{分})$ 以下である。 $0.10\text{ g}/(\text{cm}^2 \cdot \text{分})$ を越えるとシート面に乾燥割れをおこす。一方、塗布膜を乾燥するにあたっての蒸発速度が $0.001\text{ g}/(\text{cm}^2 \cdot \text{分})$ を下回ると樹脂付金属箔の生産性が低下することがあるので好ましくない。

熱硬化性樹脂が熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂もしくはポリスチレン系重合体を含む熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂であって、樹脂の溶融製膜による製造方法を採用する場合は、本件第9発明の特別な製造方法を用いることにより、樹脂膜から粉落ちすることがなく、かつ樹脂膜表面に割れのない良好な品質の樹脂付金属箔を、高い生産性で製造することができる。

本件第9発明の製造方法においては、熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂を実質的に分解させない樹脂溶融温度が選択されることが特徴である。

10

20

30

40

50

熱硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂を実質的に分解させないで溶融させ、押し出すために、溶融押し出し機の装置や溶融押し出し温度が選択される。熱硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂を実質的に分解させないで溶融させ、押し出すため溶融押し出しの温度は、50 以上、300 以下の範囲で選択される。

溶融押し出しの方法としては、押し出し部の先端にＴダイを有した単軸、あるいは多軸スクリー型溶融押し出し機、混練ゾーンを有する押し出し部の先端にＴダイを有した単軸、あるいは多軸スクリー型の溶融押し出し機などの装置を用いる方法等が挙げられる。

樹脂フロー量を1%以上50%以下、好ましくは5%以上50%以下、更に好ましくは7%以上45%以下に調節する方法は限定されない。例えば樹脂の化学構造あるいは組成の調節による方法が挙げられる。樹脂フロー量が大き過ぎる熱硬化性樹脂を熱処理あるいは光化学的処理など各樹脂に適した方法により部分的に硬化させ、樹脂フロー量を調節することも有効な手段として挙げられる。

本発明の多層配線板用樹脂付金属箔は、熱硬化性樹脂膜表面を容易に剥離可能な保護シートで被覆されることにより、実用上極めて扱いやすい、有用な多層配線板用資材となる。この、金属箔、熱硬化性樹脂膜、樹脂膜から容易に剥離可能な保護シートがこの順に密着してなる複合シートがすなわち本件第10発明である。製造方法としては、樹脂付金属箔に保護シートを加熱加圧等により圧着する手順と、逆に保護シート上に熱硬化性樹脂膜が先に形成されたものに金属箔を密着させる手順との両方が可能である。

容易に剥離可能なシートとしては、樹脂フィルムが好ましい。その中でも、耐熱性の観点からポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどが好ましい。フィルム表面がシリコン樹脂やフッ素樹脂で離型加工されても良い。

本件第1～6発明の多層配線板用樹脂付金属箔は、これを用いることにより多層配線板の各絶縁層の厚さがいたるところ実用上一定となり、特性インピーダンスがいたるところ実用上一定と見なせる多層配線板が得られるため、ひいてはその多層配線板を用いた電子機器、特に電子装置の電気特性を著しく向上させることができるため、産業上極めて有用である。絶縁層の厚み、ひいては特性インピーダンスのばらつきは $\pm 10\%$ 以内であれば実用上一定と見なせ、ばらつきが多層配線板や半導体装置の電気的特性に悪影響を及ぼさなくなる。また、熱硬化性樹脂の比誘電率が1メガヘルツ以上の周波数領域で3.3以下、好ましくは3.0以下であることにより、熱硬化後の該樹脂も比誘電率が小さい。絶縁層の比誘電率が小さいと配線の幅を広げることができるため、配線形成について同一のプロセスマージンのもとで製造しても特性インピーダンスのばらつきが小さくなる。また、クロストークが小さくなる。これらの効果が相まってはじめて、本発明の多層配線板および電子装置が極めて優れた電気的特性を有するのである。

第3～6発明においては、硬化した熱硬化性樹脂のガラス転移温度が180以上であることで多層配線板の優秀な信頼性が得られる。熱硬化した樹脂のガラス転移温度が180未満の場合、長期的な装置の使用で導体のマイグレーションによる絶縁抵抗の劣化、樹脂の劣化に起因する装置の機能の障害が発生する可能性がある。ガラス転移温度は200以上であることがより好ましい。なお、ガラス転移温度はオリエンテック社製のレオバイプロン（動的粘弾性測定装置）にて昇温速度2 / 分、35 Hzの条件で測定する。

第11発明及び第12発明においては、熱硬化した樹脂の比誘電率が1メガヘルツ以上の周波数で3.3以下であることにより、これらの多層配線板および半導体装置の優秀な電気特性が得られる。比誘電率は3.0以下であることがより好ましい。比誘電率が3.3を超えると、配線の単位長さあたりの遅延時間が大きくなり、高速デジタル回路においてタイミングマージンが小さくなってしまいクロック周波数を高くできない。また比誘電率の平方根に比例する導体損失が大きくなるため、高周波回路において信号レベルマージンが小さくなってしまい利用できる周波数帯域が狭くなる。また、特性インピーダンスのばらつきおよびクロストークが大きくなり回路の動作に悪影響を及ぼすことは前に述べた通りである。

第11発明の多層配線板の構造の例を第2図に示す。第2図において、3は硬化した熱硬

10

20

30

40

50

化性樹脂膜。4は電気絶縁性の任意の板材料、5はバイア接続ホール、6はめっきスルーホールである。

第11発明の逐次多層配線板の製造方法の例を第3図に示す。製造方法の例を順を追って説明する。

(1)例えば両面銅張積層板のように、電気絶縁性板状物8の両面に予め導体層7が形成されたものから製造を開始する。

(2)導体7を例えばエッチング等の既知の手段により回路パターン7'となす。

(3)本発明の熱硬化性樹脂付金属箔を例えば加熱加圧等の既知の手段によって積層する。導体層9と熱硬化した熱硬化性樹脂の層10が形成される。

(4)ビア穴11を形成する。

10

(5)無電解めっきに続いて電気銅めっきを行う等の公知の方法によって導体膜12を形成してビア接続を得た後、(2)と同様に回路パターンを形成する。

(6)(3)と同様に本発明の熱硬化性樹脂付金属箔により新たな導体層13及び新たな熱硬化した熱硬化性樹脂の層12を形成する。

(7)必要に応じ、従来の多層配線板製造法と同様、全層を貫くスルーホールを形成する。

(8)(5)と同様、無電解めっきに続いて電気銅めっきを行う等の公知の方法によって導体層16を形成してビア接続およびスルーホール接続を得た後、回路パターンを形成する。

第3図では6層基板を例示したが、本発明の熱硬化性樹脂付金属箔を用いれば、ビア形成、ビア接続及び回路形成を繰り返すことにより、いかなる層数の多層配線板をも逐次的に製造できることは明らかである。

20

第12発明の電子装置の構造の例を第4図乃至第6図に示す。本件第12発明は任意の構造の電子装置において使用される多層配線板に、本件発明の多層配線板を用いることによって電子装置の優秀な電気特性が得られることが特徴である。電子素子と多層配線板を接続する配線手段は構造に応じて適切な物を選べばよい。ワイヤボンディング、フリップチップ接続等が例として挙げられる。

第4図乃至第6図において、17は本発明の多層配線板、18は導体、19は半導体チップ、20は誘電体、キャパシタ、インダクタ、及び/または抵抗体等の個別電子素子、21は封止手段、22ははんだボール、23は放熱板、24はボンディングワイヤ、25は金属ピン、26はシリコンチップの接着手段である。

30

第12発明の電子装置のうち、特に電気信号の伝搬速度が到るところ1ナノ秒当たり16.5cm以上になるように設計し、かつ多層配線板の総合的な耐熱温度が180℃以上になるように選んだものが本件第13発明である。

電子装置には様々な構造のものが存在するが、本発明に関するものは、シリコンやガリウムヒ素などの半導体ウェハやインゴットから切り出された半導体又はそれをキャリアに搭載するなど扱いやすい形にしたもの、誘電体、キャパシタ、インダクタ、および/または抵抗体等の電子素子、およびそれを搭載する多層配線板を必須の構成要素とするものである。多層配線板の内部及び表面に形成されている配線を信号が伝搬する速度が1ナノ秒当たり16.5cm以上のものを使用すると、電子装置に由来する遅延時間が小さくなるばかりでなく、高速信号の扱いで問題となるデジタル信号の立ち上がりおよび立ち下りの波形の乱れが小さくなり、極めて優秀な電子装置が得られる。これが本発明の著しい効果の一つである。実際の多層配線板においては、電気信号は信号線と、それに対応する接地電位面との間の電場の振動により伝搬されるので、信号線と接地電位導体の相互の位置関係と、その間の空間を占める絶縁材料の誘電特性が設計時に考慮されなければならない。逆に、接地電位導体と電源電位導体の相互の位置関係およびその間の絶縁材料の誘電特性は重要ではない。

40

今一つの効果は多層配線板の耐熱温度が180℃以上であることにより得られる。電子装置の動作特性は高速デジタル回路や高速デジタル/アナログ混載回路においては極めて安定であることが要求される。多層配線板の耐熱温度を180℃以上とすることにより

50

、本発明の電子装置の特性が温度および湿度の変化に対して極めて変動しにくくなる。この2点の著しい効果が相まって、本件第13発明の電子装置が高速デジタル回路および高速デジタル/アナログ混載回路用の部品として真に有用なものとなっているのである。

第13発明に言う耐熱温度とは、例えば熱分解開始温度、相転移点など室温以上の温度において物質の特性が著しい変化を示すいくつかの温度のうち、最も室温に近い温度を指す。本発明における多層配線板は実用上当然各種材料の複合体であるが、本発明においてはそれら各種材料の個別の耐熱温度のうち最も室温に近い温度が多層配線板の耐熱温度である。実用上、樹脂、セラミック等混合されて一つの材料として機能する物は、複合された物を一つの成分として扱うことは言うまでもない。

本発明の逐次多層配線板において、逐次に形成する各配線層間の電気的接続を行うために従来のめっきスルーホールを形成しても良いが、高密度配線を可能にするためにはバイア接続ホール形成により層毎の接続とすることが好ましい。スルーホールとバイア接続ホールは混在させても良い。穴明けおよび層間の電気的接続は任意の方法によることができる。限定する意図ではないが、バイア接続ホールの形成手順の例を以下に説明する。バイア接続ホール形成は表面の金属箔にエッチング等の加工によりバイア接続ホールを形成したい部分にのみ穴を明けて熱硬化性樹脂層を露出させ、エキシマーレーザ、炭酸ガスレーザ、YAGレーザ等によるレーザ加工、イオンないしプラズマ等によるドライエッチング、もしくは腐食性薬品によるウェットエッチング等の方法により樹脂部分を取り除いて下の金属箔層を露出させた後、めっきあるいはスパッタリング等の方法により樹脂の穴内壁に金属膜を形成して層間接続するか、あるいは樹脂の穴内に導電性ペーストを詰めることにより接続しても良い。金属箔と樹脂層の穴明けを別々に行う方法を説明したが、勿論ドリルを用いて貫通しない深さの穴を明ける方法によっても構わない。

本発明の多層配線板は積層ビルドアップ工法によるものであるが、一部の層に感光性絶縁樹脂もしくは熱硬化性樹脂のレーザ加工と無電解厚付けめっき技術による導体形成による方法などの、他の層形成法を適用しても構わない。

本発明の電子装置において、電子素子は本発明の多層配線板の上に搭載される場合と別の板状物、例えば放熱板を兼ねた金属板やセラミック板など、の上に搭載され本発明の多層配線板は電子素子をよける形でキャビティ状に加工されて該板状物と密着される場合等が挙げられる。また、本発明の多層配線板は積層ビルドアップ工法によるものであるから、任意の板状物の上に多層配線を形成し得る。この板状物自体が金属板、メタルコア配線板、セラミック板、セラミック多層配線板等、放熱、配線機能、または特別な電気特性を実現するための機能を有するものであってもよい。

以下、本発明を一層明確にするために実施例を挙げて説明するが、本発明の範囲をこれらの実施例に限定するものではない。

(実施例1)

熱硬化性樹脂として1メガヘルツにおける比誘電率が2.7の熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂を用い、金属箔として厚さ12 μ mのプリント配線板用電解銅箔を用い、金属箔として厚さ12 μ mのプリント配線板用電解銅箔を用いて、多層配線板用樹脂付銅箔を作成した。樹脂膜の厚みは60 μ mとした。樹脂フロー量は3%であった。熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂を熱硬化させてガラス転移温度を測定したところ、220であった。比誘電率は1メガヘルツの周波数において2.8であった。18 μ mの銅箔を両面に張った0.3mm厚の熱硬化性ポリフェニレンエーテル両面銅張積層板に内層回路を形成し、その両面に上記熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂付金属箔を積層した。さらに外層回路を形成して330mm \times 400mmの4層配線板とした。この4層配線板の配線の特性インピーダンスを測定したところ、至る所プラスマイナス10%以内の安定した特性であった。この4層配線板の一部をエポキシ樹脂に包埋し、断面を研磨した後光学顕微鏡で観察したところ、内層回路は熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂によって完全に埋め込まれており、ボイドは見い出されなかった。

(実施例2)

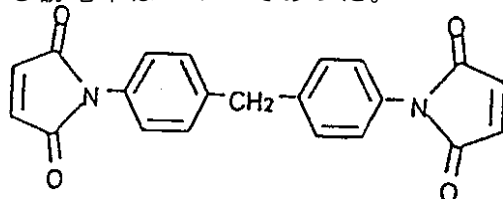
熱硬化性樹脂として１メガヘルツにおける比誘電率が２．８の熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂を用い、金属箔として厚さ１２μmのプリント配線板用電解銅箔を用いて、多層配線板用樹脂付銅箔を作成した。樹脂膜の厚みは６０μmとした。樹脂フロー量は３９％であった。熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂を熱硬化させてガラス転移温度を測定したところ、２１０℃であった。比誘電率は１メガヘルツの周波数において２．９であった。１８μmの銅箔を両面に張った０．３mm厚の熱硬化性ポリフェニレンエーテル両面銅張積層板に内層回路を形成し、その両面に上記熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂付金属箔を積層した。さらに外層回路を形成して３３０mm×４００mmの４層配線板とした。この４層配線板の配線の特性インピーダンスを測定したところ、至る所プラスマイナス１０％以内の安定した特性であった。同じ多層配線板用樹脂付き銅箔と両面銅張積層板を用いて３５mm×３５mmの半導体装置用４層配線板を作成し、デジタル半導体を搭載して半導体装置を作成した。可変クロック発生装置を備える試験用回路に該半導体装置を搭載して動作可能クロック周波数範囲を測定したところ、１００メガヘルツまで動作した。この半導体装置を１２１℃、２気圧のプレッシャークッカーで吸湿処理し、１００メガヘルツの動作を確認したところ、処理時間３０００時間まで動作に影響が表れなかった。また、－６５℃と１２５℃の間を往復させる冷熱衝撃試験を行ったところ、１０００サイクルまで動作に影響が表れなかった。

（実施例３）

実施例２の熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂１００重量部に対して、重量平均分子量５０万のポリスチレンを４重量部添加した。このポリスチレンを含む熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂の１メガヘルツにおける比誘電率は２．８であった。このポリスチレンを含む熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂と厚さ１２μmのプリント配線板用電解銅箔を用いて、多層配線板用樹脂付銅箔を作成した。滑らかな光沢を有する、厚み６０μmの樹脂膜が容易に形成できた。樹脂フロー量は４０％であった。該熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂を熱硬化させてガラス転移温度を測定したところ、２１０℃であった。比誘電率は１メガヘルツの周波数において２．９であった。１８μmの銅箔を両面に張った０．３mm厚の熱硬化性ポリフェニレンエーテル両面銅張積層板に内層回路を形成し、その両面に上記熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂付金属箔を積層した。さらに外層回路を形成して３３０mm×４００mmの４層配線板とした。この４層配線板の配線の特性インピーダンスを測定したところ、至る所プラスマイナス１０％以内の安定した特性であった。同じ多層配線板用樹脂付き銅箔と両面銅張積層板を用いて３５mm×３５mmの半導体装置用４層配線板を作成し、デジタル半導体を搭載して半導体装置を作成した。可変クロック発生装置を備える試験用回路に該半導体装置を搭載して動作可能クロック周波数範囲を測定したところ、１００メガヘルツまで動作した。この半導体装置を１２１℃、２気圧のプレッシャークッカーで吸湿処理し、１００メガヘルツの動作を確認したところ、処理時間３０００時間まで動作に影響が表れなかった。また、－６５℃と１２５℃の間を往復させる冷熱衝撃試験を行ったところ、１０００サイクルまで動作に影響が表れなかった。

（実施例４）

分子量５万のポリ（パラジビニルベンゼン）９０重量部と下記構造式１のビスマレイミド１０重量部を混合して熱硬化性樹脂を調製した。この熱硬化性樹脂の１メガヘルツにおける誘電率は２．７であった。



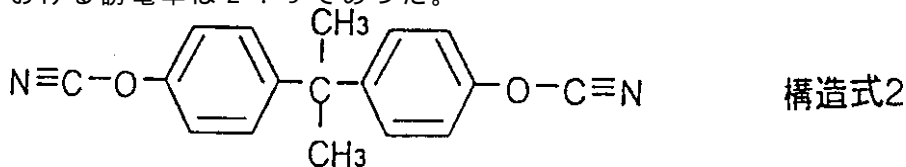
構造式１

このポリジビニルベンゼンを含む熱硬化性樹脂と厚さ１２μmのプリント配線板用電解銅箔を用いて、多層配線板用樹脂付銅箔を作成した。樹脂膜の厚みは６０μmとした。樹脂

フロー量は15%であった。該熱硬化性ポリポリジビニルベンゼン樹脂を熱硬化させてガラス転移温度を測定したところ、460であった。比誘電率は1メガヘルツの周波数において2.8であった。18 μ mの銅箔を両面に張った0.3mm厚の熱硬化性ポリフェニレンエーテル両面銅張積層板に内層回路を形成し、その両面に上記ポリジビニルベンゼン樹脂付金属箔を積層した。さらに外層回路を形成して330mm \times 400mmの4層配線板とした。この4層配線板の配線の特性インピーダンスを測定したところ、至る所プラスマイナス10%以内の安定した特性であった。同じ多層配線板用樹脂付き銅箔と両面銅張積層板を用いて35mm \times 35mmの半導体装置用4層配線板を作成し、デジタル半導体を搭載して半導体装置を作成した。可変クロック発生装置を備える試験用回路に該半導体装置を搭載して動作可能クロック周波数範囲を測定したところ、100メガヘルツまで動作した。この半導体装置を121、2気圧のプレッシャーコッカーで吸湿処理し、100メガヘルツの動作を確認したところ、処理時間3000時間まで動作に影響が表れなかった。また、-65と125の間を往復させる冷熱衝撃試験を行ったところ、1000サイクルまで動作に影響が表れなかった。

(実施例5)

下記構造式2の2官能シアン酸エステルを部分的に重合させてプレポリマーを調製した。このプレポリマーの数平均分子量は560、重量平均分子量は1310であった。プレポリマー100重量部、ノニルフェノール1重量部、コバルトオクテート0.25重量部を混合して多官能性シアン酸エステル樹脂を調製した。この熱硬化性樹脂の1メガヘルツにおける誘電率は2.9であった。



この多官能性シアン酸エステル樹脂と厚さ12 μ mのプリント配線板用電解銅箔を用いて、多層配線板用樹脂付銅箔を作成した。樹脂膜の厚みは60 μ mとした。樹脂フロー量は41%であった。該多官能性シアン酸エステル樹脂を熱硬化させてガラス転移温度を測定したところ、280であった。比誘電率は1メガヘルツの周波数において3.0であった。18 μ mの銅箔を両面に張った0.3mm厚の熱硬化性ポリフェニレンエーテル両面銅張積層板に内層回路を形成し、その両面に上記多官能性シアン酸エステル樹脂付金属箔を積層した。さらに外層回路を形成して330mm \times 400mmの4層配線板とした。この4層配線板の配線の特性インピーダンスを測定したところ、至る所プラスマイナス10%以内の安定した特性であった。同じ多層配線板用樹脂付き銅箔と両面銅張積層板を用いて35mm \times 35mmの半導体装置用4層配線板を作成し、デジタル半導体を搭載して半導体装置を作成した。可変クロック発生装置を備える試験用回路に該半導体装置を搭載して動作可能クロック周波数範囲を測定したところ、100メガヘルツまで動作した。この半導体装置を121、2気圧のプレッシャーコッカーで吸湿処理し、100メガヘルツの動作を確認したところ、処理時間3000時間まで動作に影響が表れなかった。また、-65と125の間を往復させる冷熱衝撃試験を行ったところ、1000サイクルまで動作に影響が表れなかった。

(実施例6)

数平均分子量3100のポリブタジエン100重量部、過酸化ジクミル2重量部を混合して熱硬化性樹脂を調製した。この熱硬化性樹脂の1メガヘルツにおける誘電率は2.4であった。

このポリブタジエン系熱硬化性樹脂と厚さ12 μ mのプリント配線板用電解銅箔を用いて、多層配線板用樹脂付銅箔を作成した。樹脂膜の厚みは60 μ mとした。樹脂フロー量は43%であった。該ポリブタジエン系熱硬化性樹脂を熱硬化させてガラス転移温度を測定したところ、150であった。比誘電率は1メガヘルツの周波数において2.5であった。18 μ mの銅箔を両面に張った0.3mm厚の熱硬化性ポリフェニレンエーテル両面

銅張積層板に内層回路を形成し、その両面に上記ポリブタジエン系熱硬化性樹脂付金属箔を積層した。さらに外層回路を形成して330mm×400mmの4層配線板とした。この4層配線板の配線の特性インピーダンスを測定したところ、至る所プラスマイナス10%以内の安定した特性であった。同じ多層配線板用樹脂付き銅箔と両面銅張積層板を用いて35mm×35mmの半導体装置用4層配線板を作成し、デジタル半導体を搭載して半導体装置を作成した。可変クロック発生装置を備える試験用回路に該半導体装置を搭載して動作可能クロック周波数範囲を測定したところ、100メガヘルツまで動作した。

(実施例7)

トリアリルイソシアヌレートをトルエン中、過酸化物と共に加熱して重量平均分子量3000のポリ(トリアリルイソシアヌレート)を得た。このポリトリアリルイソシアヌレート90重量部、トリアリルイソシアヌレートモノマー10重量部、および2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)ヘキシン-3を3重量部混合して熱硬化性ポリ(トリアリルイソシアヌレート)樹脂を調製した。この熱硬化性樹脂の1メガヘルツにおける誘電率は3.1であった。

このポリ(トリアリルイソシアヌレート)を含む熱硬化性樹脂と厚さ12μmのプリント配線板用電解銅箔を用いて、多層配線板用樹脂付銅箔を作成した。樹脂膜の厚みは60μmとした。樹脂フロー量は25%であった。該熱硬化性ポリ(トリアリルイソシアヌレート)樹脂を熱硬化させてガラス転移温度を測定したところ、350であった。比誘電率は1メガヘルツの周波数において3.3であった。18μmの銅箔を両面に張った0.3mm厚の熱硬化性ポリフェニレンエーテル両面銅張積層板に内層回路を形成し、その両面に上記ポリ(トリアリルイソシアヌレート)樹脂付金属箔を積層した。さらに外層回路を形成して330mm×400mmの4層配線板とした。この4層配線板の配線の特性インピーダンスを測定したところ、至る所プラスマイナス10%以内の安定した特性であった。同じ多層配線板用樹脂付き銅箔と両面銅張積層板を用いて35mm×35mmの半導体装置用4層配線板を作成し、デジタル半導体を搭載して半導体装置を作成した。可変クロック発生装置を備える試験用回路に該半導体装置を搭載して動作可能クロック周波数範囲を測定したところ、100メガヘルツまで動作した。この半導体装置を121、2気圧のプレッシャークッカーで吸湿処理し、100メガヘルツの動作を確認したところ、処理時間3000時間まで動作に影響が表れなかった。また、-65と125の間を往復させる冷熱衝撃試験を行ったところ、1000サイクルまで動作に影響が表れなかった。

(比較例1)

実施例2の熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂の代わりに銅張積層板用エポキシ樹脂を用いて樹脂付銅箔を作成し、樹脂フロー量を測定したところ65%であった。また該エポキシ樹脂を熱硬化してガラス転移温度を測定したところ、150であった。比誘電率は1メガヘルツの周波数において3.8であった。実施例1と同様に4層配線板を作成し、特性インピーダンスを測定したところ、プラスマイナス16%のばらつきがあった。デジタル半導体を搭載した半導体装置を作成し、動作可能なクロック周波数を測定したところ80メガヘルツであった。121、2気圧のプレッシャークッカーで加湿試験を行ったところ、1000時間で80メガヘルツ動作が不能となった。この半導体装置について-65と125の間を往復させる冷熱衝撃試験を行ったところ、300サイクルにて動作不能となった。

(実施例8~10)

厚さ12μmのプリント基板用電解銅箔の片面に、乾燥後の樹脂厚さが50μmとなるように実施例2の熱硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂とトルエン溶剤からなる樹脂ワニス塗布した。塗布膜を乾燥するにあたっては、熱風乾燥機を用い、塗布膜の残存溶媒濃度が20000ppmに達するまでの溶剤の蒸発速度が実施例8; 0.005g/(cm²・分)、実施例9; 0.01g/(cm²・分)、実施例10; 0.05g/(cm²・分)となるように熱風の温度・風量を調節した。得られた樹脂付シートは、塗布面の乾燥割れもなく、樹脂付金属箔のカットなどの加工時や逐次積層による多層配線板を作製す

10

20

30

40

50

る際のハンドリングにおいて粉落ちはなく、信頼性の高い多層配線板を作製することができた。

(比較例2)

実施例2の塗布膜を乾燥するにあたって、溶剤の蒸発速度が $0.2\text{ g}/(\text{cm}^2 \cdot \text{分})$ になるように熱風の温度・風量を調節する以外は、実施例8～10と同様に樹脂付金属箔を作製した。得られたシートは、塗布面には乾燥割れが見られ、樹脂付金属箔のカットなどの加工時や逐次積層による多層配線板を作製する際のハンドリングにおいて粉落ちが見られた。作製した多層配線板の断面を観察したところ回路部に樹脂の埋込み不良が発生していた。

(実施例11～13)

実施例2の熱硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂を用い、厚さ $12\text{ }\mu\text{m}$ のプリント基板用電解銅箔の片面に乾燥後の樹脂厚さが $50\text{ }\mu\text{m}$ となるように、樹脂を溶融押し出しして銅箔上に樹脂膜を形成させた。溶融押し出しの装置としては、押し出し部の先端にTダイを有した2軸スクリー型溶融押し出し機を用い、溶融押し出しの温度は、実施例11； 80°C 、実施例12； 120°C 、実施例13； 250°C となるように装置を調整し実施した。得られた樹脂付金属箔は、表面が滑らかであり、樹脂付金属箔のカットなどの加工時や逐次積層による多層配線板を作製する際のハンドリングにおいて粉落ちはなく、信頼性の高い多層配線板を作製することができた。

(比較例3)

実施例2の熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂の溶融成形膜を作製するにあたって、溶融押し出しの温度が 350°C となる以外は、実施例11～13と同様に樹脂付金属箔を作製した。得られた樹脂付金属箔の表面は滑らかではなく、樹脂付基材のカットなどの加工時や逐次積層による多層配線板を作製する際のハンドリングにおいて粉落ちが見られないものの、作製した多層配線板の断面を観察したところ回路部に樹脂の埋込み不良が発生していた。

(実施例14)

実施例2で作成した熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂付金属箔の樹脂面に厚み $10\text{ }\mu\text{m}$ ポリエチレンフィルムを 100°C のホットロールにて圧着し、該樹脂付金属箔の保護シートとした。保護シートを付けたまま、直径 10 cm の円筒に巻き付けて 23°C にて1週間保存したところ、金属箔の表面が熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂で汚染されることはなかった。また、圧着したポリエチレンフィルムの縁を指でこすったところ、端から容易に剥離できた。

(実施例15)

耐熱温度 200°C の熱硬化ポリフェニレンエーテル樹脂を絶縁樹脂とする多層配線板を作成した。配線総数を6層とした。この多層配線板の耐熱温度は 200°C であった。TDR(時間領域反射測定法)によりこの多層配線板の電気信号伝搬速度を測定したところ、いたるところ1ナノ秒当たり 17.5 cm 以上であった。この多層配線板にフィールドプログラマブルゲートアレイチップ、ダンピング抵抗、およびキャパシタを搭載した後樹脂封止して電子装置とした。この電子装置を基準クロックが 100 MHz であるデジタル回路基板に搭載したところ問題なく動作した。このデジタル回路基板を 60°C 、相対湿度 90% の条件で 1000 時間加湿した後再び動作するかどうか調べたところ、問題なく動作した。

(比較例4)

実施例15の多層配線板の代わりに通常の銅張積層板用エポキシ樹脂を絶縁樹脂とする多層配線板を用いたところ、TDRにより電気信号伝搬速度が最も大きい場所でも1ナノ秒当たり 15.0 cm であることがわかった。実施例15と同じ素子を用いて電子装置を作成し、基準クロック 100 MHz の動作試験を行ったが正常に動作しなかった。基準クロックを 70 MHz に下げたところ動作した。このデジタル回路基板を 60°C 、相対湿度 90% の条件で 1000 時間加湿した後再び動作するかどうか調べたところ、正常に動作しなかった。

10

20

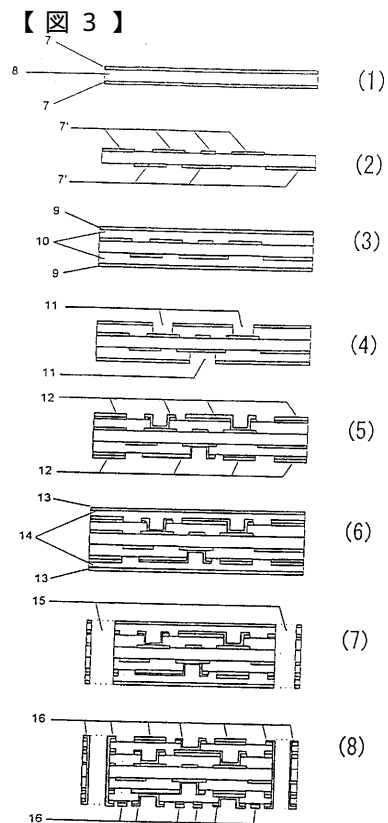
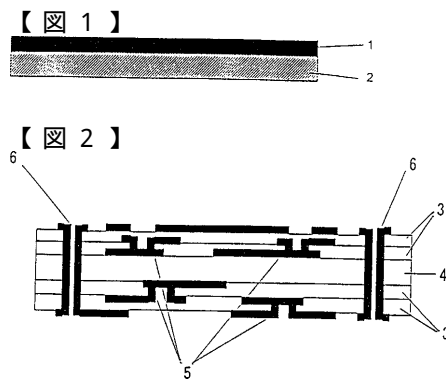
30

40

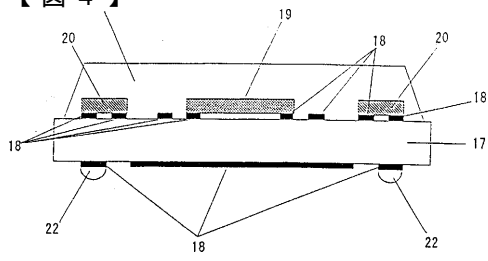
50

産業上の利用可能性

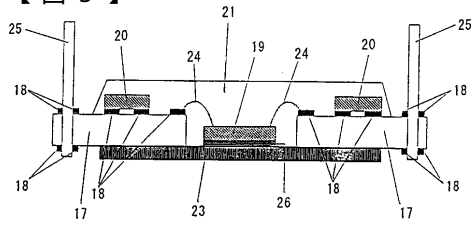
本発明の多層配線板用熱硬化性樹脂付金属箔により、積層ビルドアップ工法による特性インピーダンスの安定した高性能な多層配線板が製造できる。本発明の製造方法により、優れた品質のポリフェニレンエーテル樹脂付金属箔が製造できる。本発明の樹脂付金属箔には安価な樹脂面保護シートを圧着することができ、保管および取り扱い性に優れた樹脂付金属箔として利用できる。本発明の多層配線板は特性インピーダンスが安定し電氣的に優れた特性を有するので、従来にない高性能な高速デジタル回路および高周波回路を製造することができる。本発明の電子装置は、従来にない高速動作、高周波動作が可能な優れた装置である。



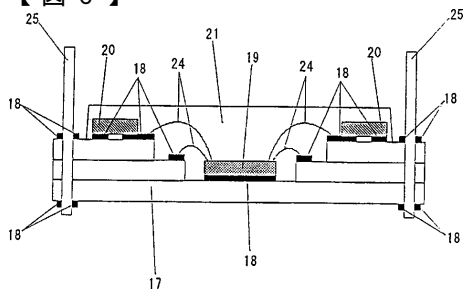
【図 4】



【図 5】



【図 6】



フロントページの続き

(72)発明者 新井 雄史

埼玉県北本市北本1丁目18番地

審査官 千葉 成就

(56)参考文献 特開平3-165596(JP,A)

特開平3-166935(JP,A)

特開平4-91940(JP,A)

特開昭61-42872(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl.⁷, DB名)

H05K 3/46